

Fotoreceptor de radiație ultravioletă pe baza structurilor cu barieră de potențial superficială ce conține un strat din semiconductori  $A^{III}B^V$ , un strat de oxid propriu tunel transparent, și un strat de  $SnO_2$  sau ITO, **caracterizat prin aceea că** în stratul din semiconductori  $A^{III}B^V$  este format un strat defect, în care timpul de viață a purtătorilor de sarcină minoritari este minim, stratul defect fiind plasat la o distanță de la suprafața stratului semiconductor nu mai mare decât lungimea de absorbție a radiației vizibile.